


ФИЗИКА – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Ф.И.О Раззоков Алижон Шоназарович

ДОЛЖНОСТЬ доцент

TEL +998919999100

E – mail: razzokov.a@bk.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕЛ: +99862 2246700

ОРГАНИЗАЦИЯ
АДРЕС: г. Ургенч, улица Х.Алимджана, дом №14

УРОВЕНЬ:

- 2004-2008 Ургенчский государственный университет
- 1996–1998 гг. Физико-технический институт АН РУз (аспирантура).
- 1987–1992 гг. Ургенчский государственный университет.

**ТРУДОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:**

- 2017г. - н.в. – Доцент кафедры «Физики», «Физико-математического» факультета Ургенчского Государственного Университета
- 2014–2017 гг. – Преподаватель математики Ургенчского академического лицея с военно-юридическим уклоном
- 2010–2012 гг.- Начальник управления областного среднеспециального и профессионального образования
- 2009–2010 гг.- Начальник отдела внедрения современных технологий, управления подготовки кадров и мониторинга применения труда кадров, Центра средне-специального и профессионального образования, Министерство Высшего и Средне-специального Образования.
- 2008–2009 гг.- Заместитель начальника главного управления подготовки кадров и мониторинга применения труда кадров, Центра средне-специального и профессионального образования, Министерство Высшего и Средне-специального Образования.

	<ul style="list-style-type: none"> • 2007–2008 гг.- Директор академического лицея №1 при ТИТУ Ургенчского филиала. • 2006–2007 гг.-Начальник отдела по учебно-воспитательной работе средне-специального, профессионального образования Хорезмской области , заместитель начальника управления. • 2005–2006гг.- Начальник отдела кадров и маркетинга управления средне-специального и профессионального образования Хорезмской области, заместитель начальника управления, руководитель контрольной группы. • 2002–2005 гг.- Зам. начальника управления средне-специального и профессионального образования Хорезмской области, начальник отдела по кадровым и маркетинговым вопросам. • 1999–2002 гг.- Докторант Физико-технического института при АН Республики Узбекистан. • 1998–1999 гг.- Научный сотрудник лаборатории “Рост кристаллов” Физико-технического института при АН Республики Узбекистан. • 1996–1998 гг.- Аспирант Физико-технического института при АН Республики Узбекистан. • 1994–1996 гг.- Ассистент преподаватель кафедры физики Ургенчского Государственного Университета. • 1993–1994 гг.- Стажёр исследователь кафедры физики Ургенчского Государственного Университета. • 1992–1993 гг.- Преподаватель по физике в средней школе им. М.Горького Янгиарыкского района Хорезмской области.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Физика-математика, экономика (микроэкономика)
ОБУЧАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Голография, теоретическая механика, молекуляр физика, общая физика, биофизика
ПОИСКОВАЯ РАБОТА	<ul style="list-style-type: none"> • Получения и исследования электрофизических, фотоэлектрических свойств полупроводниковых твердых растворов SiGe, (GaAs)(ZnSe), (Si)(GaP) из жидкой фазы
ПОВЫШЕНИЕ	

<p>КВАЛИФИКАЦИИ :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сертификат № 022258 центра повышение квалификации май-июнь Ташкент 2019 год. • Сертификат №28 центра повышение квалификации Мангейма, Федеративная Республика Германия, апрель-май 2007 год. • Сертификат №258 центра повышение квалификации Берлина, Федеративная Республика Германия, июнь 2009 год. • Институт повышения квалификации и переподготовки педагогов при ССПО №1203 февраль 2002 год. • Центр Средне-Специального Образования, «Профессиональное образование в сфере информационно-коммуникационных технологий», ориентированное на потребности рынка труда, 2010 год. • Обучающий курс «Развитие человеческих ресурсов», Министерство внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли, центр повышения квалификации кадров в сфере «ВЭД» (МВЭСИТ/ЦПКК), город Ташкент, Республика Узбекистан, 2006 год. • Повышение квалификации в «DEDEMAN», «Узбекистан и Глобальный Рынок», 2008 год.
<p>ТЕКУЩЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • А.С.Саидов, А.Ш.Раззоков. Получение и морфологические исследования эпитаксиальных слоев твердого раствора $Si_{1-x}Ge_x$; Сибирский физический журнал. Новосибирск, 2020. Том 15, №2, стр.84-90; • А.С.Саидов, А.Ш.Раззоков, Кошчанова Д.Э. Қаттиқ аралашмали яримўтказгич материалларни суюқ фазадан ўстириб олишнинг назарий асослари.; Урганч, Илм сарчашмалари, 2020 №3 стр. 14-19.; • Саидов.А.С, Раззоков А.Ш, Исмаилов.Ш.К, Асатова.У.П Жидкофазная эпитакция твердых растворов растворов $(Ge_2)_{1-x}(InP)_x$ и $(GaAs)_{1-x-y}(Ge_2)(ZnSe)_y$; “ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРИЯ” Международный научный журнал №2.1/2017.; • А.Ш.Раззоков, А.Р.Матназаров, М.А.Латипова, А.И.Жапаков. Физико-химические основы выращивания варизонного полупроводникового $Si_{1-x}Ge_x$ твердого раствора из жидкой фазы; Научный журнал

«Бюллетень науки и практики» том 6, №9, 2020, Стр. 10-17.

- A.S.Saidov, A.Sh.Razzokov, Sh/K.Ismoilov, U.P.Asatova Liquid-phase epitaxy of solid solutions $(\text{Ge})_{1-x}(\text{In})_x$ and $(\text{GaAs})_{1-x-y}(\text{ZnSe})_x$; Республиканская научная конференции “СПФКС-2016” Бухоро-2016. Стр. 176.
- Саидов А.С., Раззоков А.Ш., Сапаров Д.В. «О ширине запрещенной зоны полупроводников»; Международная конференция «Актуальные проблемы молекулярной спектроскопии конденсированных сред. Самарканд, 22-24 сентября 2016 г.
- А.С. Саидов, А.Ш.Раззоков, Д.В.Сапаров «Закономерности образования запрещенной зоны полупроводников»; Республиканская конференция «Возобновляемой источники энергии: технологии и установки». Ташкент, 14-15 июня 2016 г.
- Saidov A.S., Saparov D.V., Usmanova S.S., Razzokov A.Sh. «The influence of the nanosized crystals on the spectral photosensitivity of the $p\text{Si}-n(\text{Si}_2)_{1-x}(\text{GaP})_x$ heterostructure»; New Trends of Development Fundamental and Applied Physics:Problems, Achievements and Prospects, 10-11 November 2016, Tashkent, Uzbekistan.
- Саидов А.С., Сапаров Д.В., Раззоков А. «Температурная зависимость вольтамперной характеристики $p\text{Si}-n(\text{Si}_2)_{1-x}(\text{GaP})_x$ гетероструктуры»; Международная конференция. «Фундаментальные и прикладные вопросы физики», Ташкент, 13-14 июнь. 2017, стр. 180-181.
- Сапаров Д.В.Саидов А.С, Раззоков А. Ш., Кутлимуратов Б.Р. «Спектральная чувствительность $p\text{Si}-n(\text{Si}_2)_{1-x}(\text{GaP})_x$ гетероструктур». ; Республиканская научная конференция «Неравновесные процессы в полупроводниках и полупроводниковых структурах» 1-2 февраль. 2017. Ташкент.
- Раззоков А. Ш., Юлдашева Г.Г. Лаборатория машғулотларидаги зарурий назарий ва амалий билимлар; “Актуальные вызовы современной науки” XXVI Международная научная конференция 26-27 июня 2018 г. Украина, вып. 6(26), стр. 136-140.
- Саидов А.С., Сапаров Д.В., Раззоков А. Ш. «Получение и фотолюминесценция варизонного твердого раствора

pSi– n (Si₂)_{1-x} (GaP)_x с нанокристаллами»; Материалы Республиканской конференции «Роль одаренной молодежи в развитии физики» Национальный Университет Узбекистана. Тошкент. 18 май 2019.;

- А.Ш.Раззоков, Д.Ш.Курбанов. Зависимость дислокаций на твердом растворе Si_{1-x}Ge_x от температур роста на контактной фазе «Твердое тело-жидкость»; РИАК-ХИИ. Ташкент 2020 г. Стр 275-277.
- А.Ш.Раззоков, Д.Э.Кошчанова Температурная зависимость растворимости германия в жидких металлах с учетом их обобщенных моментов; РИАК-ХИИ. Ташкент 2020 г. Стр 313-316.
- А.Ш.Раззоков, Д.Ш.Курбанов. Получения полупроводниковых твердых растворов на основе кремния и германия; “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами 22-23 сентябр Қарши-2020, стр. 98-99.
- А.Ш.Раззоков, Д.Э.Кошчанова. (C^{VI}/₂)_{1-x} (A^{III}B^V)_x, (C^{VI}/₂)_{1-x} (A^{II}B^{VI})_x ва бошқа синфларга оид яримўтказгич эпитаксиал қатламларини олишнинг илмий башорат асослари; “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами 22-23 сентябр Қарши-2020, бет. 266-267.
- Раззоков А.Ш., Хакимов Н.З, Давлетов И.Ю., Вапаев М.Э.Новый подход для расчета «Потенциала многоэлектронного атома»; Материалы V Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах. 13-14 ноября 2020 года Фергана. стр. 322-324.
- Раззоков А.Ш., Хакимов Н.З., Давлетов И.Ю., Эшчонов Х.О., Матназаров А.Р.Получение структурно совершенного полупроводникового твердого раствора Si_{1-x} Ge_x с заданными электрофизическими и фотоэлектрическими свойствами; Материалы V Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах. 13-14 ноября 2020 года Фергана. стр. 324-327.
- Razzokov A.Sh., Khakimov N.Z, Davletov I.Y.,

	<p>Eshchanov Kh.O., Matnazarov A.R. OBTAINING A STRUCTURALLY PERFECT SEMICONDUCTOR SOLID SOLUTION $Si_{1-x}Ge_x$ WITH SPECIFIED ELECTROPHYSICAL AND PHOTOELECTRIC PROPERTIES Scientific-technical journal 2020, V.24, №5. pp 51-60</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Раззаков А. Ш., Латипова М. А., Кадиров А. Х. Получение варизонного твердого раствора $Si_{1-x}Ge_x$ из жидкой фазы // Бюллетень науки и практики. 2021. Т. 7. №3. С. 200-205. https://doi.org/10.33619/2414-2948/64/20 <i>Cite</i>